

INF8594E

8К (1Кх8) - ЭСППЗУ с I²С-ИНТЕРФЕЙСОМ

ИМС INA2586 представляет собой электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство - ЭСППЗУ емкостью 8-Кбит (организация 1024 х 8-бит) реализованная на базе NМОП технологии с плавающим затвором. ИМС работает в системе с I²С-шиной с возможностью присоединения до 4-х ИМС INA2586 к I²С-шине. В основу программирования устройства заложен эффект туннелирования электронов. Программирующее напряжение генерируется внутри кристалла в блоке умножителя напряжения. Функционально данная ИМС соответствует изделию SDA2586, Siemens. Микросхема реализуется в 8-выв DIP и 8-выв. SOP корпусах.

Отличительные особенности:

Энергонезависимое хранение информации в течении 10 лет

Один источник питания (U_{сс}=4,75 В - 5,25 В)

Встроенный умножитель напряжения

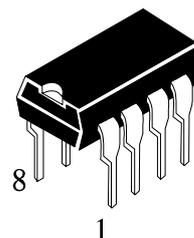
Последовательный I²С-интерфейс

Гарантия 10000 циклов СТИРАНИЕ/ЗАПИСЬ;

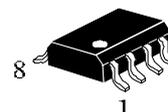
Внутренняя структура обеспечивает перепрограммирование (не требуется внешних компонентов)

Длительность цикла СТИРАНИЕ/ЗАПИСЬ 15 мс

Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +70°C



Индекс D
SO



Индекс N
Plastic
DIP

Обозначение
в корпусе

микросхемы

INA2586N Plastic DIP

INA2586D SO

T_A = от минус 40 до плюс 85 °C
для всех корпусов

Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	U _{сс}	GND
02	CS0	Выбор ИМС
03	CS1	Выбор ИМС
04	CS2/TD	Тестирование вывода (0В – нормальный режим, 5В - стирание)
05	SDA	Информационная линия, вход/выход
06	SCL	Вход синхронизации
07	NC	Не используется
08	U _{сс}	Вывод питания от источника напряжения

INF8594E

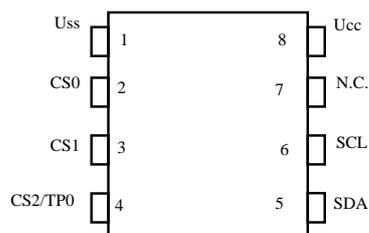


Рисунок 1 - Обозначение выводов в корпусе

Электрические параметры

Параметр	Режим измерения	Обозначение	Мин.	Макс.
Ток потребления, мА	$U_{CC}=5.25\text{ В}$	I_{CC0}	-	20,0
Выходное напряжение низкого уровня (SDA), В	$f_{OL}=3\text{ мА}$ $U_{CC}=4.75\text{ В}$	U_{OL}	-	0,4
Ток утечки: - по выходу (SDA), мкА - по входам SCL, SDA, мкА - по входам CS, TP1, TP2, мкА	$U_{OH}=5,25\text{ В}$ $U_{IH}=5,25\text{ В}$ $U_{IH}=5,25\text{ В}$	I_{LOH} I_{LIH} I_{LIH}	- - -	10,0 10,0 100,0
Входная емкость, пФ	$U_I=0\text{ В}$	C_I	-	10,0
Тактовая частота, кГц		f_{SCL}	0	100
Длительность цикла перепрограммирования, мс	СТИРАНИЕ И ЗАПИСЬ	t_{PROG}	10,0	20,0
Длительность цикла стирания, мс	$U_{TP2}=5,0\text{ В}$	t_{ER}	-	20,0
Количество циклов перепрограммирования 1 байта			10 000	-
Входное напряжение высокого уровня -входы SDA, SCL, В -входы CS, TP1, TP2, В		U_{IH}	3,0 4,5	U_{CC} U_{CC}
Входное напряжение низкого уровня: -входы SDA, SCL, В -входы CS, TP1, TP2, В		U_{IL}	- -	1,5 0,2